(19)日本国特許庁(JP)

(12) 公開特許公報(A)

(11)特許出願公開番号 特開2001-176981 (P2001-176981A)

(43)公開日 平成13年6月29日(2001.6.29)

(51) Int.Cl. ⁷	
H01L	21/82
G06F	17/50

識別記号

FΙ

H01L 21/82

テーマコート*(参考) W 5B046

G06F 15/60

658J 5F064

審査請求 有 請求項の数16 OL (全 16 頁)

(21)出願番号

特願平11-363393

(22)出願日

平成11年12月21日(1999.12.21)

(71)出願人 000232036

日本電気アイシーマイコンシステム株式会

社

神奈川県川崎市中原区小杉町1丁目403番

53

(72)発明者 加藤 利和

神奈川県川崎市中原区小杉町一丁目403番

53 日本電気アイシーマイコンシステム株

式会社内

(74)代理人 100082935

弁理士 京本 直樹 (外2名)

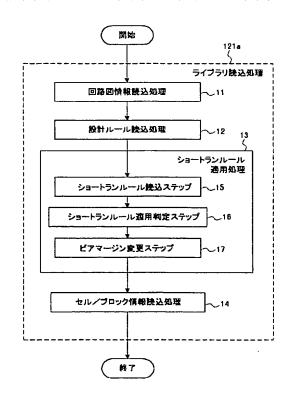
最終頁に続く

(54) 【発明の名称】 自動配置配線システムの配線方法および自動配置配線システムの配線方法を記録した記録媒体

(57)【要約】

【課題】ショートランルールに対応していない自動配置 配線システムでショートランルールを有効利用した配線 を実行できるようにする。

【解決手段】ショートランルール適用判定ステップ16 で配線間隔が最も小さい個所であるビアセルと配線またはビアセルとの対向配置個所にショートランルールが適用できるか否かを判定し、適用できる場合にはビアマージン変更ステップ17でショートランルール制限のない配線最小間隔を満足するようにビアマージンを削減した配線時ビアセルデータを作成しこれを用いて自動配線処理を実行し、配線結果の出力処理において配線時ビアセルデータを本来のビアマージンを有するビアセルのアートワークデータに置き換えて出力する。



【特許請求の範囲】

【請求項1】 所定の配線ピッチで設定されたグリッド 上に配置配線する自動配置配線システムの配線方法にお いて

方形状のビアと前記ビアを覆いかつ四方にビアマージン 分広げて設けられた上層配線層および下層配線層とを有 しライブラリに登録されたビアセルの配線層パタンと該 ビアセルが配置されたグリッドの隣接グリッドに対向配 置される配線層パタンとの配線間隔が所定の対向長限度 内で所定の間隔まで許容するショートラン配線間隔以上 であることを検出して対向配置時の配線間隔が配線長制 限のない配線最小間隔を満たすように前記ビアマージン を設定した配線時ビアセルデータを作成し、

前記配線時ビアセルデータを用いて前記自動配置配線システムにより配置配線した後に前記配線時ビアセルデータを前記ビアセルに対応したアートワークデータに置換することを特徴とする自動配置配線システムの配線方法。

【請求項2】 所定の配線ピッチで設定されたグリッド 上に配置配線する自動配置配線システムの配線方法にお いて、

方形状のビアと前記ビアを覆いかつ四方にビアマージン 分広げて設けられた上層配線層および下層配線層とを有 しライブラリに登録されたビアセル同士が隣接グリッド に対向配置されるときの配線間隔が所定の対向長限度内 で所定の間隔まで許容するショートラン配線間隔以上で あることを検出して前記ビアセルを基に対向配置時の配 線間隔が配線長制限のない配線最小間隔を満たすように 前記ビアマージンを変更した配線時ビアセルデータを作 成し、

前記配線時ビアセルデータを用いて前記自動配置配線システムにより配置配線した後に前記配線時ビアセルデータを前記ビアセルに対応したアートワークデータに置換することを特徴とする自動配置配線システムの配線方法。

【請求項3】 配置配線の実行に先立ち回路図情報、設計ルール、セル/ブロックライブラリを含む情報を読み込むライブラリ読込処理において、ビアセル同士が隣接グリッドに対向配置されるときの配線間隔が所定の対向長限度内で所定の間隔まで許容するショートラン配線間隔以上であることを検出して前記ビアセルを基に対向配置時の配線間隔が配線長制限のない配線最小間隔を満たすようにビアマージンを変更した配線時ビアセルデータを作成するショートランルール適用処理を有することを特徴とする請求項2記載の自動配置配線システムの配線方法。

【請求項4】 前記ショートランルール適用処理が、 ショートランルール適用可能な所定の対向長限度値と許 容できるショートラン配線間隔とを含む情報を読み込む ショートランルール読込ステップと、 ビアセル同士が隣接グリッドに対向配置されるときの配線間隔が前記ショートラン配線間隔以上になることを検出したときにショートランルール適用可能と判定してビアマージン変更フラグを変更有り側に設定するショートランルール適用判定ステップと、

前記ショートランルール適用判定ステップでビアマージン変更フラグが変更有り側に設定されたときに前記ビアセルを基に対向配置時の配線間隔が配線長制限のない配線最小間隔を満たすようにビアマージンを変更した配線時ビアセルデータを作成するビアマージン変更ステップとを有することを特徴とする請求項3記載の自動配置配線システムの配線方法。

【請求項5】 所定の配線ピッチで設定されたグリッド 上に配置配線する自動配置配線システムの配線方法において

方形状のビアと前記ビアを覆いかつ四方にビアマージン 分広げて設けられた上層配線層および下層配線層とを有 しライブラリに登録されたビアセルと該ビアセルが配置 されたグリッドの隣接グリッドに対向配置される配線と の配線間隔が対向配線長制限のない配線最小間隔未満で かつ所定の対向長限度内で所定の間隔まで許容するショ ートラン配線間隔以上であることを検出して前記ビアセ ルを基に対向配置時の配線間隔が前記配線最小間隔を満 たすように前記ビアマージンを変更した配線時ビアセル データを作成し、

前記配線時ビアセルデータを用いて前記自動配置配線システムにより配置配線した後に前記配線時ビアセルデータを前記ビアセルに対応したアートワークデータに置換することを特徴とする自動配置配線システムの配線方法。

【請求項6】 配置配線の実行に先立ち回路図情報、設計ルール、セル/ブロックライブラリを含む情報を読み込むライブラリ読込処理において、ビアセルと該ビアセルが配置されたグリッドの隣接グリッドに対向配置される配線との配線間隔が対向配線長制限のない配線最小間隔未満でかつ所定の対向長限度内で所定の間隔まで許容するショートラン配線間隔以上になることを検出し前記ビアセルを基に対向配置時の配線間隔が前記配線最小間隔を満たすようにビアマージンを変更した配線時ビアセルデータを作成するショートランルール適用処理を有することを特徴とする請求項5記載の自動配置配線システムの配線方法。

【請求項7】 前記ショートランルール適用処理が、ショートランルール適用可能な所定の対向長限度値と許容できるショートラン配線間隔とを含む情報を読み込むショートランルール読込ステップと、

ビアセルと該ビアセルが配置されたグリッドの隣接グリッドに対向配置されるときの配線間隔が対向配線長制限のない配線最小間隔未満でかつ前記ショートラン配線間50 隔以上になることを検出したときにショートランルール

3

適用可能と判定してビアマージン変更フラグを変更有り 側に設定するショートランルール適用判定ステップと、 前記ショートランルール適用判定ステップでビアマージン変更フラグが変更有り側に設定されたときに前記ビアセルを基に対向配置時の配線間隔が前記配線最小間隔を満たすようにビアマージンを変更した配線時ビアセルデータを作成するビアマージン変更ステップとを有することを特徴とする請求項6記載の自動配置配線システムの配線方法。

【請求項8】 前記ショートランルール読込ステップが、

配置配線時にショートランルールを適用するかを判定する第1のサブステップと、

前記第1のサブステップで適用すると判定されたときに ショートランルールで指定されるショートラン配線間隔 を読み込む第2のサブステップと、

ショートランルールの対向長限度値を読み込む第3のサ ブステップと、

ビアの辺長にビアマージンの2倍を加えてビアセル配線 層幅を算出する第4のサブステップと、

前記ビアセル配線層幅が前記対向長限度値以下であるか を判定し対向長限度値以下であれば前記ショートランル ール適用判定ステップに進む第5のサブステップと、

前記第1のサブステップで適用しないと判定されたとき 又は前記第5のサブステップで前記ビアセル配線層幅が 対向配線長限度値以下ではないと判定されたときにビア マージン変更フラグを変更無し側に設定して前記ビアマ ージン変更ステップに進む第6のサブステップとを有す ることを特徴とする請求項4,7記載の自動配置配線シ ステムの配線方法。

【請求項9】 前記ショートランルール適用判定ステップが、

ビアの辺長にビアマージンの2倍を加えてビアセル配線 層幅を算出する第1のサブステップと、

前記ビアセル配線層幅が設計ルールで指定され信号配線 に適用される標準配線幅よりも大きいかを判定する第2 のサブステップと、

前記第2のサブステップで大きいと判定されたときに設計ルールで指定された配線ピッチから前記ビアセル配線 層幅を減じて理論最小間隔を求める第3のサブステップと、

前記理論最小間隔がショートラン配線間隔以上かを判定 する第4のサブステップと、

前記第4のサブステップで前記ショートラン配線間隔以上であると判定されたときにビアマージン変更フラグを変更有り側に設定して前記ビアマージン変更ステップに進む第5のサブステップと、

前記第2のサブステップで前記ビアセル配線層幅が前記 標準配線幅より大きくはないと判定されたとき又は前記 第4のサブステップで前記理論最小間隔が前記ショート ラン配線間隔以下ではないと判定されたときにビアマージン変更フラグを変更無し側に設定して前記ビアマージン変更ステップに進む第6のサブステップとを有することを特徴とする請求項4記載の自動配置配線システムの配線方法。

【請求項10】 前記ビアマージン変更ステップが、 ビアマージン変更フラグが変更有り側に設定されている かを判定する第1のサブステップと、

前記第1のサブステップで変更有り側に設定されていると判定されたときにピアの辺長にピアマージンの2倍を加算して得られるピアセル配線層幅を設計ルールで指定された配線ピッチから減じて得られる理論最小間隔からさらに配線最小間隔を減じて2で除したものにピアマージンを加えて仮想マージンを算出する第2のサブステップと

前記ビアマージンを前記仮想マージンに変更する第3の サブステップと、

前記第1のサブステップでビアマージン変更フラグが変更有り側に設定されていないと判定されたとき又は前記第3のサブステップを実行した後に移行して自動配置配線に使用する配線時マージンを決定し配線時ビアセルデータを作成する第4のサブステップとを有することを特徴とする請求項4記載の自動配置配線システムの配線方法。

【請求項11】 前記ショートランルール適用判定ステップが、

ビアの辺長にビアマージンの 2 倍を加えてビアセル配線 層幅を算出する第1のサブステップと、

前記ビアセル配線層幅が設計ルールで指定され信号配線 30 に適用される標準配線幅よりも大きいかを判定する第2 のサブステップと、

前記第2のサブステップで大きいと判定されたときに前 記ビアセル配線層幅に前記標準配線幅を加算して2で除 したものを設計ルールで指定された配線ピッチから減じ て理論最小間隔を求める第3のサブステップと、

前記理論最小間隔が配線最小間隔未満でかつショートラン配線間隔以上の範囲内にあるかを判定する第4のサブステップと、

前記第4のサブステップで前記範囲内にあると判定されたときにピアマージン変更フラグを変更有り側に設定して前記ピアマージン変更ステップに進む第5のサブステップと、

前記第2のサブステップで前記ビアセル配線層幅が前記標準配線幅より大きくはないと判定されたとき又は前記第4のサブステップで前記理論最小間隔が前記範囲内にないと判定されたときにビアマージン変更フラグを変更無し側に設定して前記ビアマージン変更ステップに進む第6のサブステップとを有することを特徴とする請求項7記載の自動配置配線システムの配線方法。

【請求項12】 前記ビアマージン変更ステップが、

ビアマージン変更フラグが変更有り側に設定されている かを判定する第1のサブステップと、

前記第1のサブステップで変更有り側に設定されていると判定されたときにピアの辺長にピアマージンの2倍を加算して得られるピアセル配線層幅に設計ルールで定められる標準配線幅を加算して2で除したものを設計ルールで指定された配線ピッチから減じて得た理論最小間隔をもとにさらにピアマージンを加え配線最小間隔を減じて仮想マージンを算出する第2のサブステップと、

前記ピアマージンを前記仮想マージンに変更する第3の サブステップと、

前記第1のサブステップでビアマージン変更フラグが変 更有り側に設定されていないと判定されたとき又は前記 第3のサブステップを実行した後に移行して自動配置配 線に使用する配線時マージンを決定し配線時ビアセルデ ータを作成する第4のサブステップとを有することを特 徴とする請求項7記載の自動配置配線システムの配線方 法。

【請求項13】 ショートランルール適用可能な所定の 対向長限度値と許容できるショートラン配線間隔とを含 む情報を読み込む第1のプログラムと、

ビアセル同士が隣接グリッドに対向配置されるときの配線間隔が前記ショートラン配線間隔以上になることを検出したときにショートランルール適用可能と判定してビアマージン変更フラグを変更有り側に設定する第2のプログラムと、

前記第2のプログラムで前記ビアマージン変更フラグが変更有り側に設定されたときに前記ビアセルを基に対向配置時の配線間隔が配線長制限のない配線最小間隔を満たすようにビアマージンを変更した配線時ビアセルデータを作成する第3のプログラムと、

配置されたプロック及びセル間の配線を前記配線時ピア セルデータを用いて行う第4のプログラムと、

配線完了後に前記配線時ビアセルデータを前記ビアセル に対応したアートワークデータに置換する第5のプログ ラムとを有することを特徴とする自動配置配線システム の配線方法を記録したコンピュータ読み取り可能な記録 媒体。

【請求項14】 前記第1のプログラムが、

配置配線時にショートランルールを適用するかを判定する第1のステップと、前記第1のステップで適用すると判定されたときにショートランルールで指定されるショートラン配線間隔を読み込む第2のステップと、

ショートランルールの対向長限度値を読み込む第3のステップと.

ビアの辺長にビアマージンの2倍を加えてビアセル配線 層幅を算出する第4のステップと、

前記ピアセル配線層幅が前記対向長限度値以下であるか を判定し対向長限度値以下であれば前記前記第2のプロ グラムに進む第5のステップと、 前記第1のステップで適用しないと判定されたとき又は 前記第5のステップで前記ビアセル配線層幅が対向配線 長限度値以下ではないと判定されたときにビアマージン 変更フラグを変更無し側に設定して前記第3のプログラムに進む第6のステップとを有し、

前記第2のプログラムが、

前記ビアセル配線層幅が設計ルールで指定され信号配線 に適用される標準配線幅よりも大きいかを判定する第7 のステップと、

10 前記第7のステップで大きいと判定されたときに設計ルールで指定された配線ピッチから前記ビアセル配線層幅 を減じて理論最小間隔を求める第8のステップと、

前記理論最小間隔がショートラン配線間隔以上かを判定 する第9のステップと、

前記第9のステップで前記ショートラン配線間隔以上であると判定されたときにビアマージン変更フラグを変更有り側に設定して前記第3のプログラムに進む第10のステップと、

前記第7のステップで前記ビアセル配線層幅が前記標準配線幅より大きくはないと判定されたとき又は前記第9のステップで前記理論最小間隔が前記ショートラン配線間隔以下ではないと判定されたときにビアマージン変更フラグを変更無し側に設定して前記第3のプログラムに進む第11のステップとを有し、

前記第3のプログラムが、

前記ビアマージン変更フラグが変更有り側に設定されて いるかを判定する第12のステップと、

前記第12のステップで変更有り側に設定されていると 判定されたときに前記理論最小間隔から設計ルールで定 められた配線最小間隔を減じて2で除したものに前記ビ アマージンを加えて仮想マージンを算出する第13のス テップと、

前記ビアマージンを前記仮想マージンに変更する第14 のステップと、

前記第12のステップで前記ビアマージン変更フラグが変更有り側に設定されていないと判定されたとき又は前記第14のステップを実行した後に移行して自動配置配線実行時の配線時マージンを決定し配線時ビアセルデータを作成する第15のステップとを有する請求項13記載の自動配置配線システムの配線方法を記録したコンピュータ読み取り可能な記録媒体。

【請求項15】 ショートランルール適用可能な所定の 対向長限度値と許容できるショートラン配線間隔とを含 む情報を読み込む第1のプログラムと、

ビアセルと該ビアセルが配置されたグリッドの隣接グリッドに対向配置されるときの配線間隔が対向配線長制限のない配線最小間隔未満でかつ前記ショートラン配線間隔以上になることを検出したときにショートランルール適用可能と判定してビアマージン変更フラグを変更有り50 側に設定する第2のプログラムと、

前記第2のプログラムで前記ビアマージン変更フラグが 変更有り側に設定されたときに前記ビアセルを基に対向 配置時の配線間隔が前記配線最小間隔を満たすようにビ アマージンを変更した配線時ビアセルデータを作成する 第3のプログラムと、

配置されたブロック及びセル間の配線を前記配線時ビア セルデータを用いて行う第4のプログラムと、

配線完了後に前記配線時ビアセルデータを前記ビアセル に対応したアートワークデータに置換する第5のプログ ラムとを有することを特徴とする自動配置配線システム の配線方法を記録したコンピュータ読み取り可能な記録 媒体。

【請求項16】 前記第1のプログラムが、

配置配線時にショートランルールを適用するかを判定す る第1のステップと、

前記第1のステップで適用すると判定されたときにショ ートランルールで指定されるショートラン配線間隔を読 み込む第2のステップと、

ショートランルールの対向長限度値を読み込む第3のス テップと、

ビアの辺長にビアマージンの2倍を加えてビアセル配線 層幅を算出する第4のステップと、

前記ビアセル配線層幅が前記対向長限度値以下であるか を判定し対向長限度値以下であれば前記前記第2のプロ グラムに進む第5のステップと、

前記第1のステップで適用しないと判定されたとき又は 前記第5のステップで前記ビアセル配線層幅が対向配線 長限度値以下ではないと判定されたときにビアマージン 変更フラグを変更無し側に設定して前記第3のプログラ ムに進む第6のステップとを有し、

前記第2のプログラムが、

前記ビアセル配線層幅が設計ルールで指定され信号配線 に適用される標準配線幅よりも大きいかを判定する第7 のステップと、

前記第7のステップで大きいと判定されたときに前記ビ アセル配線層幅に前記標準配線幅を加算して2で除した ものを設計ルールで指定された配線ピッチから減じて理 論最小間隔を求める第8のステップと、

前記理論最小間隔が配線最小間隔未満でかつショートラ ン配線間隔以上の範囲内にあるかを判定する第9のステ ップと、

前記第9のステップで前記範囲内にあると判定されたと きにビアマージン変更フラグを変更有り側に設定して前 記第3のプログラムに進む第10のステップと、

前記第7のステップで前記ビアセル配線層幅が前記標準 配線幅より大きくはないと判定されたとき又は前記第9 のステップで前記理論最小間隔が前記範囲内にはないと 判定されたときにビアマージン変更フラグを変更無し側 に設定して前記第3のプログラムに進む第11のステッ プとを有し、

前記第3のプログラムが、

前記ビアマージン変更フラグが変更有り側に設定されて いるかを判定する第12のステップと、

前記第12のステップで変更有り側に設定されていると 判定されたときに前記理論最小間隔に前記ピアマージン を加え前記配線最小間隔を減じて仮想マージンを算出す る第13のステップと、

前記ビアマージンを前記仮想マージンに変更する第14 のステップと、

前記第12のステップで前記ビアマージン変更フラグが 変更有り側に設定されていないと判定されたとき又は前 記第14のステップを実行した後に移行して自動配置配 線実行時の配線時マージンを決定し配線時ビアセルデー タを作成する第15のステップとを有する請求項15記 載の自動配置配線システムの配線方法を記録したコンピ ユータ読み取り可能な記録媒体。

【発明の詳細な説明】

[0001]

20

【発明の属する技術分野】本発明は、自動配置配線シス テムの配線方法に関し、特に所定の条件を満たすときに 設計ルールに定められた配線最小間隔よりも小さい配線 間隔を部分的に許容するショートランルールを適用して 配線可能な自動配置配線システムの配線方法および自動 配置配線システムの配線方法を記録した記録媒体に関す る。

[0002]

【従来の技術】大規模集積回路(LSI)のレイアウト 設計においては、ライブラリとして準備されている論理 機能単位(ブロック)を用いて記述された回路図および 30 チップサイズをもとに、ライブラリにある配線に関する 情報を用いてチップ全体の配線に関するアートワークデ ータを作成する。アートワークデータの作成は、通常、 コンピュータを用いたCAD(Computer Aided Design) による自動配置配線システムを用いて行われる。近年の LSIチップの大規模化、高密度化の急激な進展に伴 い、自動配置配線システムにおいても自動配線密度の向 上が望まれている。このため自動配置配線システムに対 して、より多層の配線層を使用した配線機能を装備する とともに、異なる配線層間を接続するビアを多数含んで も高密度に配線できるように性能向上要求が強まってい る。

【0003】次に、従来使用されている自動配線システ ムの構成および配置配線フローの概要について説明す る。図11は、自動配置配線システムの構成図である。 自動配置配線システム1は、読込/前処理手段6によ り、回路図情報ファイル2から設計対象LSIを構成す る各ブロックの端子間の接続情報を読み込み、セル/ブ ロックライブラリ3に登録されたビアやNANDゲート などのセル情報、複雑な論理機能を実現するブロックの 50 情報から、設計対象LSIに使用するセル/ブロックに

-5-

関するアートワークデータを読み込み、設計ルールファイル4から各配線層の配線ピッチ、配線幅および配線最小間隔、ビアセルを構成する各要素の寸法等の配置配線時および検証時に使用する設計ルールを読み込む。読み込んだ情報に基づいて、自動配置配線手段本体7は配置配線用のデータを作成し、配置配線を実行する。配置配線の実行結果は配置配線結果検証手段8により検証され、不具合がなければアートワークデータに再変換した後に自動配置配線システム1から配置配線結果出力ファイル5に出力される。不具合が発見された場合には、カイル5に出力される。不具合が発見された場合には、カークを記載を表していない入力/編集手段により不具合点の修正および配置配線の再実行等が行われる。

【0004】図12は、配置配線処理全体のフロー図で ある。ライブラリ読込処理121では、予め回路図情報 ファイル2, セル/ブロックライブラリ3, 設計ルール ファイル4にライブラリデータとして登録しておいた回 路図情報、配線ピッチ、配線幅、配線の最小間隔、ビア の辺長、配置するブロックの情報を、自動配置配線シス テムが読み込んで配置配線のルール設定を行う。セル/ ブロック配置処理122では、回路図に記述されている プリミティブセルおよび論理機能ブロックをLSIチッ プ内に自動的に配置する。セル/ブロック間配線処理1 23では、設定された配置配線ルールにしたがって各セ ル/ブロックの端子間を自動配線する。配置配線検証処 理124では、未配置ブロック、配線の未接続部やショ ート部等の不具合が無いことを検証し、最終的に配置配 線済データ出力処理125で配置配線システム用のデー タをLSIを構成する各層のパターンに対応したアート ワークデータに変換して配置配線結果出力ファイル5に 出力し、終了する。

【0005】図13は、図12におけるライブラリ読込処理121の詳細フロー図である。従来のライブラリ読込処理121は、回路図情報を回路図情報ファイル2から自動配置配線システムに読み込む回路図情報読込処理131と、設計ルール情報を設計ルールファイル4から読み込む設計ルール読込処理132と、配置配線に使用するセル/ブロックの情報をセル/ブロックライブラリ3から読み込むセル/ブロック情報読込処理133からなる。

【0006】 設計ルール読込処理132はさらに、配線用のグリッドの間隔を示す配線ピッチPを読み込むステップ134と、信号配線の標準的な配線幅Wを読み込むステップ135と、配線と他の配線との間隔の許容最小値である配線最小間隔Sを読み込むステップ136と、ピアセルのピアの辺長Vを読み込むステップ137と、ピアマージンMを読み込むステップ138とを有している。

【0007】図14(a)はビアセルの平面図であり、 /ブロック間配線処理123と配置配線検証処理124(b)はLSIに搭載したときの断面模式図である。図 50 との間に挿入して実行される。この第3の従来例におい

14 (a) のビアセル23において、上層の配線と下層の配線とを接続するビア141は辺長がVの正方形状であり、(b) のように上層の配線層21aおよび下層配線層22aは、LSI製造時のリソグラフィ工程において下層の配線層パターンとビアとの間およびビアと上層の配線層パターンとの間に重ね合わせのズレが生じてもビア141が上層配線層21aおよび下層配線層22aからはみ出すことが無いように、ビアの四方にビアマージンMを設けて下層配線層22aおよび上層配線層21aを広げている。142はシリコン酸化膜等の絶縁層である。

【0008】図13において、セル/ブロック情報読込処理133は、ビアセル23のアートワークセル名を読み込むステップ139と、配置に使用するセル/ブロック情報を読み込むステップ140とを有している。

【0009】従来の配線方法によるアートワークデータ出力を模式的に示した配線例図を図15(a) および(b) に示す。図15(a) の第1従来例の配線例図は、設計ルールが、配線ピッチP=1.00 μ m, 配線幅W=0. 50μ m, 配線最小間隔S=0. 50μ m, ビアの辺長V=0. 50μ m, ビアマージンM=0. 05μ mとした場合である。配線同士が隣接したグリッドに対向して配置された個所の配線間隔は(P-W)=0. 50μ mであり配線最小間隔S=0. 50μ mを満足するが、ビアセルが配線と対向して配置された個所の配線間隔は(P-V-M)=0. 45μ mとなり、またビアセル同士が対向して配置された個所の配線間隔は(P-V-M-M)=0. 45μ mとなり、いずれも配

線最小間隔 S=0. 50μ mを満足しない。このために 図 15 (a) のようにビアセル 23 の周囲は 1 ピッチ分 空けて他の配線 21 又はビアセル 23 を配置しなければ ならないので、この配線例では占有面積 A=15. 00 μ m^2 となり、ブロック間の配線に対するビアセルの割 合が多くなるほど占有面積が増大することになる。な お、21 は上層の配線で、22 は下層配線である。

【0011】図16は特開平3-29343号公報に記載された第3従来例の配線方法のビアセル置換処理フロー図である。ビアセル置換処理160は、図12のセル/ブロック間配線処理123と配置配線検証処理124との間に挿入して実行される。この第3の従来例におい

ては、図17の配線例図に示すように、ビアセル17 1,172等の原点位置の異なる複数のビアセルを準備 しておき、ビアが設けられた個所の周囲の状況を認識し て複数の原点の異なるビアセルの中から適切なビアセル を選択して置換する。

【0012】図16において、まずステップ161で配置配線済データを読み込み、ステップ162で原点の異なる複数のビアセルの読み込みを行い、ステップ163でビアセルが設けられた各個所の周囲の配線状態の認識を行い、ステップ164で各ビアセルの原点の認識を行い、ステップ165で、図17の第3従来例の配線例図に示すようにビアがビアセルと配線およびビアセル同士の配線間隔配線最小間隔Sを満たす範囲で小となるように各ビアセルを最適な原点位置をもつビアセルの選択変更を行い、ステップ166で変更したビアセルへの置換を行う。

【0013】結果として図17のように原点の異なるビアセル171,172が配置され、この配線例では配線ピッチ $P=1.00\mu$ mとして占有面積 $A=12.00\mu$ m²で配線することができる。第3実施例は、第1実施例より必ず占有面積が小さくでき、第2実施例と比較してもビアセル個数が少ない場合には有利となる。しかしながら、近年の大規模なLSIにおいては、使用するビアセルの個数は数百万個にも上り、各ビアセルについて4種類乃至5種類の原点の異なるビアセルの中から周囲の配線状態から最適の原点のビアセルを選択するには十時間を越える処理時間を必要とする。

[0014]

【発明が解決しようとする課題】従来の設計ルールで は、許容される配線間隔の最小値は配線最小間隔Sで定 められる1種類のみであったが、近年ではあらたに、所 定の対向配線長限度値SL以下であれば配線最小値より も小さい所定の配線間隔であるショートラン配線間隔S Sまで許容するショートランルールが採用され、論理機 能ブロックの高密度化に効果を上げている。しかしなが ら図11の自動配置配線手段本体7自体には、ショート ランルールに対応して配線最小間隔Sとショートラン間 隔SSの2つの間隔制限を考慮して最適な配線を行うも のは未だ無く、制限値として大きい方の配線最小間隔S のみを考慮して配線せざるを得ないために面積削減は第 1, 第2, 第3従来例として説明した配線方法によるし かなく、自動配置配線システムによる配線においてはシ ョートランルールを有効に活用してLSIチップの面積 を低減することが困難であった。

【0015】本発明の目的は、自動配置配線システムによる配線であってもショートランルールを有効に活用することができ、LSIチップの面積を低減することのできる自動配置配線システムの配線方法を提供することにある。

[0016]

【課題を解決するための手段】本発明の第1の発明の自 動配置配線システムの配線方法は、所定の配線ピッチで 設定されたグリッド上に配置配線する自動配置配線シス テムの配線方法において、方形状のビアと前記ビアを覆 いかつ四方にビアマージン分広げて設けられた上層配線 層および下層配線層とを有しライブラリに登録されたビ アセル同士が隣接グリッドに対向配置されるときの配線 間隔が所定の対向長限度内で所定の間隔まで許容するシ ョートラン配線間隔以上であることを検出して前記ビア セルを基に対向配置時の配線間隔が配線長制限のない配 線最小間隔を満たすように前記ビアマージンを変更した 配線時ビアセルデータを作成し、前記配線時ビアセルデ ータを用いて前記自動配置配線システムにより配置配線 した後に前記配線時ビアセルデータを前記ビアセルに対 応したアートワークデータに置換することを特徴として いる。

【0017】第1の発明では、配置配線の実行に先立ち 回路図情報、設計ルール、セル/ブロックライブラリを 含む情報を読み込むライブラリ読込処理において、ビア セル同士が隣接グリッドに対向配置されるときの配線間 隔が所定の対向長限度内で所定の間隔まで許容するショ ートラン配線間隔以上であることを検出して前記ビアセ ルを基に対向配置時の配線間隔が配線長制限のない配線 最小間隔を満たすようにビアマージンを変更した配線時 ビアセルデータを作成するショートランルール適用処理 を有してもよい。さらに、前記ショートランルール適用 処理が、ショートランルール適用可能な所定の対向長限 度値と許容できるショートラン配線間隔とを含む情報を 読み込むショートランルール読込ステップと、ビアセル 同士が隣接グリッドに対向配置されるときの配線間隔が 前記ショートラン配線間隔以上になることを検出したと きにショートランルール適用可能と判定してビアマージ ン変更フラグを変更有り側に設定するショートランルー ル適用判定ステップと、前記ショートランルール適用判 定ステップでビアマージン変更フラグが変更有り側に設 定されたときに前記ビアセルを基に対向配置時の配線間 隔が配線長制限のない配線最小間隔を満たすようにビア マージンを変更した配線時ビアセルデータを作成するビ アマージン変更ステップとを有してもよい。

40 【0018】第2の発明の自動配置配線システムの配線 方法は、所定の配線ピッチで設定されたグリッド上に配 置配線する自動配置配線システムの配線方法において、 方形状のビアと前記ビアを覆いかつ四方にビアマージン 分広げて設けられた上層配線層および下層配線層とを有 しライブラリに登録されたビアセルと該ビアセルが配置 されたグリッドの隣接グリッドに対向配置される配線と の配線間隔が対向配線長制限のない配線最小間隔未満で かつ所定の対向長限度内で所定の間隔まで許容するショ ートラン配線間隔以上であることを検出して前記ビアセ ルを基に対向配置時の配線間隔が前記配線最小間隔を満

30

40

13

たすように前記ビアマージンを変更した配線時ビアセル データを作成し、前記配線時ビアセルデータを用いて前 記自動配置配線システムにより配置配線した後に前記配 線時ビアセルデータを前記ビアセルに対応したアートワ ークデータに置換することを特徴としている。

【0019】第2の発明では、配置配線の実行に先立ち 回路図情報、設計ルール、セル/ブロックライブラリを 含む情報を読み込むライブラリ読込処理において、ビア セルと該ビアセルが配置されたグリッドの隣接グリッド に対向配置される配線との配線間隔が対向配線長制限の ない配線最小間隔未満でかつ所定の対向長限度内で所定 の間隔まで許容するショートラン配線間隔以上になるこ とを検出し前記ビアセルを基に対向配置時の配線間隔が 前記配線最小間隔を満たすようにビアマージンを変更し た配線時ビアセルデータを作成するショートランルール 適用処理を有してもよい。さらに、前記ショートランル ール適用処理が、ショートランルール適用可能な所定の 対向長限度値と許容できるショートラン配線間隔とを含 む情報を読み込むショートランルール読込ステップと、 ビアセルと該ビアセルが配置されたグリッドの隣接グリ ッドに対向配置されるときの配線間隔が対向配線長制限 のない配線最小間隔未満でかつ前記ショートラン配線間 隔以上になることを検出したときにショートランルール 適用可能と判定してビアマージン変更フラグを変更有り 側に設定するショートランルール適用判定ステップと、 前記ショートランルール適用判定ステップでビアマージ ン変更フラグが変更有り側に設定されたときに前記ビア セルを基に対向配置時の配線間隔が前記配線最小間隔を 満たすようにビアマージンを変更した配線時ビアセルデ ータを作成するビアマージン変更ステップとを有しても

【0020】第3の発明の自動配置配線システムの配線 方法を記録したコンピュータ読み取り可能な記録媒体 は、ショートランルール適用可能な所定の対向長限度値 と許容できるショートラン配線間隔とを含む情報を読み 込む第1のプログラムと、ビアセル同士が隣接グリッド に対向配置されるときの配線間隔が前記ショートラン配 線間隔以上になることを検出したときにショートランル ール適用可能と判定してビアマージン変更フラグを変更 有り側に設定する第2のプログラムと、前記第2のプロ グラムで前記ビアマージン変更フラグが変更有り側に設 定されたときに前記ビアセルを基に対向配置時の配線間 隔が配線長制限のない配線最小間隔を満たすようにビア マージンを変更した配線時ビアセルデータを作成する第 3のプログラムと、配置されたブロック及びセル間の配 線を前記配線時ビアセルデータを用いて行う第4のプロ グラムと、配線完了後に前記配線時ビアセルデータを前 記ビアセルに対応したアートワークデータに置換する第 5のプログラムとを有している。

方法を記録したコンピュータ読み取り可能な記録媒体 は、ショートランルール適用可能な所定の対向長限度値 と許容できるショートラン配線間隔とを含む情報を読み 込む第1のプログラムと、ビアセルと該ビアセルが配置 されたグリッドの隣接グリッドに対向配置されるときの 配線間隔が対向配線長制限のない配線最小間隔未満でか つ前記ショートラン配線間隔以上になることを検出した ときにショートランルール適用可能と判定してビアマー ジン変更フラグを変更有り側に設定する第2のプログラ ムと、前記第2のプログラムで前記ビアマージン変更フ ラグが変更有り側に設定されたときに前記ビアセルを基 に対向配置時の配線間隔が前記配線最小間隔を満たすよ うにビアマージンを変更した配線時ビアセルデータを作 成する第3のプログラムと、配置されたブロック及びセ ル間の配線を前記配線時ビアセルデータを用いて行う第 4のプログラムと、配線完了後に前記配線時ビアセルデ ータを前記ビアセルに対応したアートワークデータに置 換する第5のプログラムとを有している。

[0022]

【発明の実施の形態】本発明の配線方法は、配線間隔が 最も小さい個所であるビアセルと配線またはビアセルと の対向配置個所にショートランルールが適用できるか否 かを判定し、適用できる場合にはショートランルール制 限のない配線最小間隔を満足するようにビアマージンを 削減した自動配線処理専用の配線時ビアセルデータを作 成して自動配線処理を実行し、配線結果の出力処理にお いて配線時ビアセルデータを本来のビアマージンを有す るビアセルのアートワークデータに置き換えて出力する ことにより、ショートランルールに対応していない自動 配置配線システムでショートランルールを有効利用した 配線を実行できるようにするものである。

【0023】以下に、本発明について図面を参照して詳 細に説明する。図1は、本発明の一実施形態のライブラ リ読込処理のフロー図である。本実施の形態において、 自動配置配線システムおよび入力ファイル出力ファイル の構成は、読込/前処理手段6で実行する処理以外は図 11の従来の構成と同一であり、また配置配線処理全体 のフローもライブラリ読込処理121以外は図12の従 来例で説明したものと同一であるので、本実施の形態に おける自動配置配線システムの構成と配置配線処理全体 のフローについての説明は省略する。

【0024】図1において、ライブラリ読込処理121 aは、回路図情報読込処理11と、設計ルール読込処理 12と、ショートランルール適用処理13と、セル/ブ ロック情報読込処理14とを有している。本実施の形態 は、図12のライブラリ読込処理121に換えて図1の ライプラリ読込処理121aを用いるものであり、さら に詳細には、図13の従来のライブラリ読込処理のフロ -の設計ルール読込処理132とセルブロック情報読込 【0021】第4の発明の自動配置配線システムの配線 50 処理133との間にショートランルール適用処理13を

挿入したものである。図1の回路図情報読込処理11は 図13の従来の回路図情報読込処理131と同一の処理 であり、同様に設計ルール読込処理12は設計ルール読 込処理132と同一の処理であり、セル/プロック情報 読込処理14はセル/ブロック情報読込処理133と同 一の処理であるので、これらについても説明を省略す る。

【0025】さらに、ライブラリ読込処理121a内の ショートランルール適用処理13は、ショートランルー ルを適用可能な対向長限度値と許容できるショートラン 配線間隔とを含む情報を読み込むショートランルール読 込ステップ15と、ビアセルの配線層パタンと該ビアセ ルが配置されたグリッドの隣接グリッドに対向配置され る配線層パタンとの配線間隔がショートラン配線間隔以 上になることを検出したときにショートランルール適用 可能と判定してビアマージン変更フラグを変更有り側に 設定するショートランルール適用判定ステップ16と、 ショートランルール適用判定ステップでビアマージン変 更フラグが変更有り側に設定されたときにビアセルのデ ータを基に対向配置時の配線間隔が配線長制限のない配 線最小間隔を満たすようにビアマージンを変更した配線 時ビアセルデータを作成するビアマージン変更ステップ 17とを有している。

【0026】図2(a), (b)は、本実施の形態にお ける配線およびビアセルに関する設計ルールの一例を示 す図である。ビアセル23は下層配線22と上層の配線 21との接続に設けられ、辺長 Vの正方形状のビアを覆 って四方にビアマージンMだけ広がった下層および上層 の配線層パターンを有している。配線21と別の同層の 配線21とは最小でも配線ピッチPの間隔をあけたグリ ッド上に配置され、それぞれの配線21は信号配線の標 準的な配線幅Wを有している。配線21と別の配線21 とは配線最小間隔S以上の間隔を維持して配線する必要 があるが、ショートランルールで定められた対向長限度 値SL以下の対向長の範囲では、ショートラン配線間隔 SSまでの配線間隔が許容される。したがって全般的に は配線ピッチP≥ (W+S) であるが、対向配線長がS L以下の個所に限りP≥ (W+SS) まで許容される。 【0027】次に、ショートランルール読込ステップ1 5. ショートランルール適用判定ステップ16, ビアマ ージン変更ステップ17の詳細について説明するととも に、ショートランルールの対向長限度値SL=1.00 μm、ショートラン間隔SS=0.40μmとして例題 を用いて具体的に説明する。例題は第1従来例、第2従 来例、第3従来例と同様に、配線ピッチP=1.00 μ m, 配線幅W=0. $50\mu m$, 配線最小間隔S=0. 5 $0 \mu m$, ピアの辺長 $V=0.50 \mu m$, ビアマージンM = 0. 05μmとし、ビア同士の隣接グリッド対向配置

【0028】図3は、図1のショートランルール読込ス 50

を許容するものとする。

テップ15の詳細フロー図である。ショートランルール 読込ステップ15では、まずサブステップ31では、自 動配置配線においてショートランルールを適用するか否 かを判定する。

【0029】サブステップ31でショートランルールを 適用すると判定された場合には、サブステップ32に進 み、ショートランルールで指定されるショートラン配線 間隔SSを読み込む。次に、サブステップ33に進み、 ショートランルールの対向長限度値SLを読み込む。

【0030】次のサブステップ34では、ビアの辺長VにビアマージンMの2倍を加えてビアセル配線層幅V2Mを算出、すなわち、V2M=(V+M+M)の計算を行う。次のサブステップ35では、ビアセル配線層幅V2Mが前記対向長限度値SL以下であるか、すなわち $V2M \le SL$ を満たすかを判定し、これを満たす場合にはショートランルール読込ステップ15を終了してショートランルール適用判定ステップ16に進む。

【0031】サブステップ31でショートランルールを適用しないと判定された場合、又はサブステップ35で V2M≦SLを満たさないと判定された場合には、サブステップ36に進み、ビアマージン変更フラグを変更無し側に設定からショートラン読込ステップ15を終了してビアマージン変更ステップ17に進む。

【0032】例題では、サブステップ34でビアセル配線層幅V2M=0.50+0.05+0.05=0.60μmとなり、対向長限度値SL=1.00μmなので、V2M≦SLを満足するので、ショートランルール適用判定ステップ16に進む。

【0033】なお、サブステップ31に関連して、ショートランルールを有効とするか無効とするかの指定は予めライブラリ中に登録しておいてもよく、または自動配置配線システムの起動時に外部から指定してもよい。また、設計ルールが予めV2M≤SLを満足するように定められている場合には、サブステップ33,サブステップ35を削除してもよい。

【0034】図4は、ショートランルール適用判定ステップ16の詳細フロー図である。まず、サブステップ41で、ビアの辺長にビアマージンの2倍を加えてビアセル配線層幅V2Mを算出する。ショートランルール読込ステップ15のサブステップ34で既にビアセル配線層幅V2Mを計算済のときには、サブステップ41を省略してもよい。

【0035】次にサブステップ42に進み、ビアセル配線層幅V2Mが、信号配線に適用される標準配線幅Wよりも大きいか、すなわちV2M>Wを満足するかを判定する。サブステップ42でV2M>Wを満足すると判定された場合にはサブステップ43に進み、配線ピッチPからビアセル配線層幅V2Mを減じて理論最小間隔S1の算出、すなわちS1=(P-V2M)の計算を行う。

【0036】次にサブステップ44に進み、理論最小間

隔S1がショートラン配線間隔SS以上であるか、すな わちS1≧SSを満足するかを判定する。S1≧SSを 満足する場合にはサブステップ45に進み、ビアマージ ン変更フラグを変更有り側に設定し、ショートランルー ル適用判定ステップ16を終了してピアマージン変更ス テップ17に進む。

【0037】サブステップ42でV2M>Wを満足しな いと判定された場合又はサブステップ44でS1≧SS を満足しないと判定された場合にはサブステップ46に 進み、ビアマージン変更フラグを変更無し側に設定して ショートランルール適用判定ステップ16を終了してビ アマージン変更ステップ17に進む。

【0038】例題では、サブステップ41でビアセル配 線層幅 V 2 M = 0. 60 μ m となり、サブステップ 42 で配線幅W=0.50μmに対してV2M>Wを満足す ると判定されるので、サブステップ43に進んで理論最 小間隔 S $1 = (1.00 - 0.60) = 0.40 \mu$ mが 算出される。サブステップ44でS1=SS=0.40 μmなのでS1≧SSを満足すると判定され、サブステ ップ45でビアマージン変更フラグを変更有り側に設定 20 し、ビアマージン変更ステップ17に進む。。

【0039】図5は、ビアマージン変更ステップ17の 詳細フロー図である。まず、サブステップ51でビアマ ージン変更フラグが変更有り側に設定されているかを判 定する。ビアマージン変更フラグが変更有り側に設定さ れていると判定された場合にはサブステップ52に進 み、ショートランルール適用判定ステップ16のサブス テップ43で算出した理論最小間隔S1から配線最小間 隔Sを減じて2で除したものにビアマージンMを加えて 仮想マージンM1を算出、すなわち仮想マージンM1= M+(S1-S)/2を計算する。次に、サブステップ 53に進み、ビアマージンMを前記仮想マージンM1に 変更する。

【0040】サブステップ51でビアマージン変更フラ グが変更有り側に設定されていないと判定された場合又 はサブステップ53を実行した後に進み、自動配置配線 に使用する配線時マージンMRを決定し配線時ビアセル データを作成してビアマージン変更ステップ17を終了 する。この結果として、サブステップ51でビアマージ ン変更フラグが変更有り側にセットされたと判定された 場合には、配線時ビアセルデータの配線時マージンMR はサブステップ52で算出した仮想ビアマージンM1に 等しくなり、サブステップ51でビアマージン変更フラ グが変更有り側にセットされていないと判定された場合 には、配線時ビアセルデータの配線時マージンMRは散 計ルールに定められたビアマージンMに等しくなる。

【0041】例題では、サブステップ51でビアマージ ン変更フラグが変更有り側であると判定されて、サブス テップ52で仮想マージンM1=(0.05+(0.4 0-0.50) $\angle 2$)=0 μ mと算出され、サブステッ 50 形態とは異なる。第1,第2実施形態で共通なショート

プ54で配線時ビアセルデータの配線時ビアマージンM $R = 0 \mu m が決定される。$

【0042】ビアマージン変更ステップ17終了後は、 図1のセル/ブロック情報読込処理14に進み、図13 の従来フローのセルブロック情報読込処理133におけ ると同様に、ビア部分のアートワークデータを示すアー トワークセル名を読み込んでビアセルデータに付加す る。アートワークデータそのもののビアマージンはM (例題では 0.05 μm) である。

【0043】本実施の形態の適用により、図12におけ る自動配置配線システム1によるセル/ブロック間配線 処理123を実行するときには、ビアマージンとして配 線時ビアマージンMR (例題では0μm) に変更された 配線時ビアセルデータを用いるので、図6の配線結果を 模式的に示した図にあるように、配線対向個所、配線時 ビアセル対向個所のいずれにおいても配線最小間隔Sを 満足するため、配置配線検証処理124において不具合 が検出されることはない。

【0044】配置配線済データ出力処理125におい て、配線結果の配線時ビアセルデータに対応するビアセ ルのアートワークセル名を検出してアートワークデータ を出力することにより、図6におけるビアマージン0μ mの配線時ビアセル61は本来のビアマージン0.05 μmのビアセル23に置き換えられて出力される。図7 は、本実施の形態を適用したときの配置例図である。配 線ピッチ1.00μmのグリッド上にビアセル23同士 が対向配置されているが、ビアセルの配線層同士の間隔 がショートランルールを満たすことはショートランルー ル適用処理13により保証されており、ショートランル ールを有効に使用できるので、図7では占有面積A= 9. 00 μm² となり、第1, 第2, 第3 従来例のいず れよりも占有面積を低減した配線が可能となる。

【0045】図3,図4,図5では、ビアセル同士の対 向配置を許容する自動配置配線システムにおいて、最も 配線間隔の小さいビアセル同士の対向配置個所にショー トランルールが適用できるか否かを判定して、適用でき る場合にビアセル同士の配線層間隔が配線最小間隔を満 足するようにビアマージンを変更した。しかしながら、 ビアマージンが大きい設計ルールを用いて自動配線する ときには、ビアセル同士の対向配置個所で制約されて配 線ピッチが大きくなることを回避するために、配線と配 線およびビアセルと配線の対向配置のみを許容し、ビア セル同士の対向配置を禁止した自動配置配線システムを 用いることが多い。第2実施形態として、このような自 動配置配線システムにショートランルールを有効に適用 できる配線方法を述べる。

【0046】第2実施形態では、図1のショートランル ール適用処理13の中のショートランルール適用判定ス テップ16とビアマージン変更ステップ17が第1実施

ランルール読込ステップの説明は省略して、以下に、変 更されたステップについて説明する。

【0047】図8は、ショートランルール適用判定ステップ16aの詳細フロー図である。まず、サブステップ81で、ビアの辺長にビアマージンの2倍を加えてビアセル配線層幅V2Mを算出する。ショートランルール読込ステップ15のサブステップ34で既にビアセル配線層幅V2Mを計算済のときには、サブステップ81を省略してもよいことは図4と同様である。

【0048】次にサブステップ82に進み、ビアセル配線層幅V2Mが、信号配線に適用される標準配線幅Wよりも大きいか、すなわちV2M>Wを満足するかを判定する。サブステップ82でV2M>Wを満足すると判定された場合にはサブステップ83に進み、ビアセル配線層幅V2Mに配線幅Wを加えて2で除したものを配線ピッチPから減じて理論最小間隔S2の算出、すなわちS2=(P-(V2M+W)/2)の計算を行う。

【0049】次にサブステップ84に進み、理論最小間隔S2が配線最小間隔S未満でかつショートラン配線間隔SS以上の範囲内にあるか、すなわちS2≧SSを満足するかを判定する。S>S2≧SSを満足する場合にはサブステップ85に進み、ビアマージン変更フラグを変更有り側に設定し、ショートランルール適用判定ステップ16aを終了してビアマージン変更ステップ17aに進む。

【0050】サブステップ82でV2M>Wを満足しないと判定された場合又はサブステップ84でS>S2≧SSを満足しないと判定された場合にはサブステップ86に進み、ビアマージン変更フラグを変更無し側に設定してショートランルール適用判定ステップ16aを終了してビアマージン変更ステップ17aに進む。

【0051】図9は、ビアマージン変更ステップ17aの詳細フロー図である。まず、サブステップ91でビアマージン変更フラグが変更有り側に設定されているかを判定する。ビアマージン変更フラグが変更有り側に設定されていると判定された場合にはサブステップ92に進み、ショートランルール適用判定ステップ16aのサブステップ83で算出した理論最小間隔S2から配線最小間隔Sを減じたものにビアマージンMを加えて仮想マージンM2を算出、すなわち仮想マージンM2=M+(S2-S)を計算する。次に、サブステップ93に進み、ビアマージンMを前記仮想マージンM2に変更する。

【②1】本発明グが変更有り側に設定されていないと判定された場合又はサブステップ93を実行した後に進み、自動配置配線に使用する配線時マージンMRを決定し配線時ビアセルデータを作成してビアマージン変更ステップ17aを終了する。この結果として、サブステップ91でビアマージン変更フラグが変更有り側にセットされたと判定されて以名・1000円のである。に場合には、配線時ビアセルデータの配線時マージンM 50 ロー図である。

Rはサブステップ92で算出した仮想ビアマージンM2に等しくなり、サブステップ91でビアマージン変更フラグが変更有り側にセットされていないと判定された場合には、配線時ビアセルデータの配線時マージンMRは設計ルールに定められたビアマージンMに等しくなる。

20

【0053】以降の配線、出力等の処理については、第1実施形態と同じである。図10は第2実施形態の配線例図である。ビアマージンが大きいビアセル101と配線21との間隔はショートラン間隔SS以上を確保して配線される。

【0054】なお、図8のショートランルール適用判定ステップ16aにおいて、サブステップ84の判定条件を、図3のショートランルール適用判定ステップ16のサブステップ44と同様に、単にS2≧SSを満たすか否かとしてもよく、また、図3のサブステップ44の判定条件を、図8のサブステップ84と同様に、S>S1≧Sを満たすか否かとしてもよい。

【0055】また、図5のビアマージン変更ステップ17のサブステップ53ではビアマージンMを仮想ビアマージンM1に置き換えているが、サブステップ53で0≤M≤M1の範囲の任意の値にビアマージンMを再設定するとしても、本発明の効果に実用上の支障はない。同様に図9のビアマージン変更ステップ17aのサブステップ93を、0≤M≤M2の範囲の任意の値にビアマージンMを再設定するとしても支障はない。

[0056]

【発明の効果】以上説明したように、本発明の配線方法では、配線間隔が最も小さい個所であるビアセルと配線またはビアセルとの対向配置個所にショートランルールが適用できるか否かを判定し、適用できる場合にはショートランルール制限のない配線最小間隔を満足するようにビアマージンを削減した自動配線処理を実行し、配線時ビアセルデータを作成して自動配線処理を実行し、配線結果の出力処理において配線時ビアセルデータを本来のビアセルのアートワークデータに置き換えて出力するので、ショートランルールに対応していない自動配置配線システムにおいてもショートランルールを有効利用した配線を実行できるようにすることが可能となり、配線領域を大幅に低減することができしいう効果がある。

【図面の簡単な説明】

【図1】本発明の第1実施形態のライブラリ読込処理の フロー図である。

【図2】本実施の形態における配線およびビアセルに関する設計ルールの一例を示す図である。

【図3】ショートランルール読込ステップの詳細フロー図である。

【図4】ショートランルール適用判定ステップの詳細フロー図である。

【図5】ビアマージン変更ステップの詳細フロー図である。

【図6】配線結果を模式的に示した図である。

【図7】第1実施形態を適用したときの配置例図である。

【図8】第2実施形態のショートランルール適用判定ステップの詳細フロー図である。

【図9】第2実施形態のビアマージン変更ステップの詳細フロー図である。

【図10】第2実施形態の配線例図である。

【図11】自動配置配線システムの構成図である。

【図12】配置配線処理全体のフロー図である。

【図13】従来のライブラリ読込処理の詳細フロー図である。

【図14】 (a) はビアセルの平面図であり、(b) は LSIに搭載したときの断面模式図である。

【図15】 (a) は第1従来例の配線例図で、(b) は第2従来例の配線例図である。

【図16】第3従来例の配線方法のビアセル置換処理フロー図である。

【図17】第3従来例の配線例図である。

【符号の説明】

1 自動配置配線システム

2 回路図情報ファイル

3 セル/ブロックライブラリ

4 設計ルールファイル

5 配置配線結果出力ファイル

6 読込/前処理手段

7 自動配置配線手段本体

8 配置配線結果検証手段

11,131 回路図情報読込処理

12, 132 設計ルール読込処理

13 ショートランルール適用処理

14,133 セル/プロック情報読込処理

15 ショートランルール読込ステップ

16, 16 a ショートランルール適用判定ステップ

17.17a ビアマージン変更ステップ

21 配線

10 22 下層配線

23.101 ビアセル

6 1 配線時ピアセル

121, 121a ライブラリ読込処理

122 セル/ブロック配置処理

123 セル/ブロック間配線処理

124 配置配線検証処理

125 配置配線済データ出力処理

141 ビア

142 絶縁層

20 160 ビアセル置換処理

171, 172 原点の異なるビアセル

M ビアマージン

P 配線ピッチ

S 配線最小間隔

SL ショートランルールの対向長限度値

【図12】

終了

SS ショートラン間隔

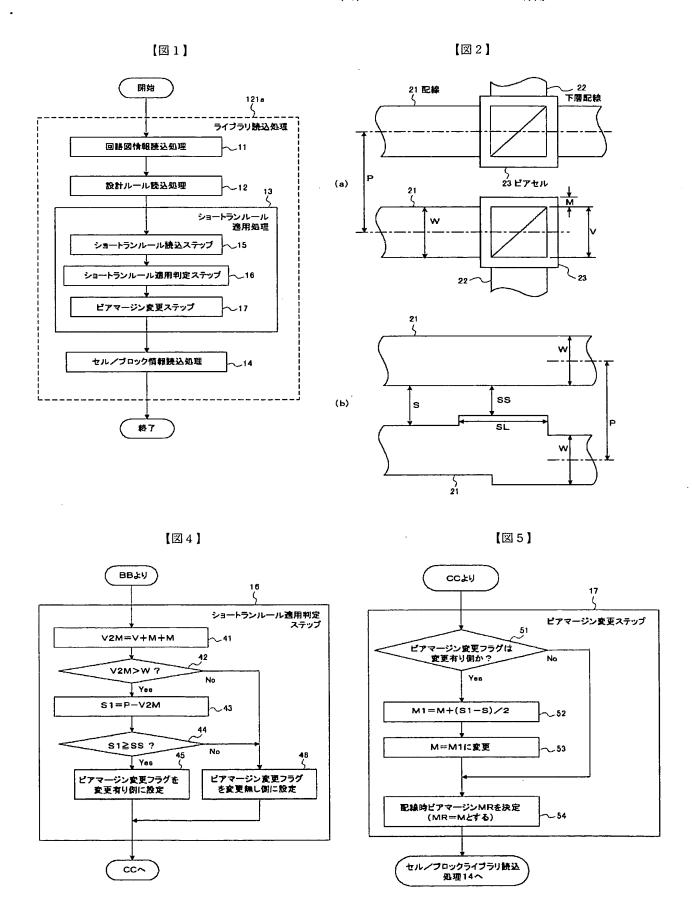
V ビアの辺長

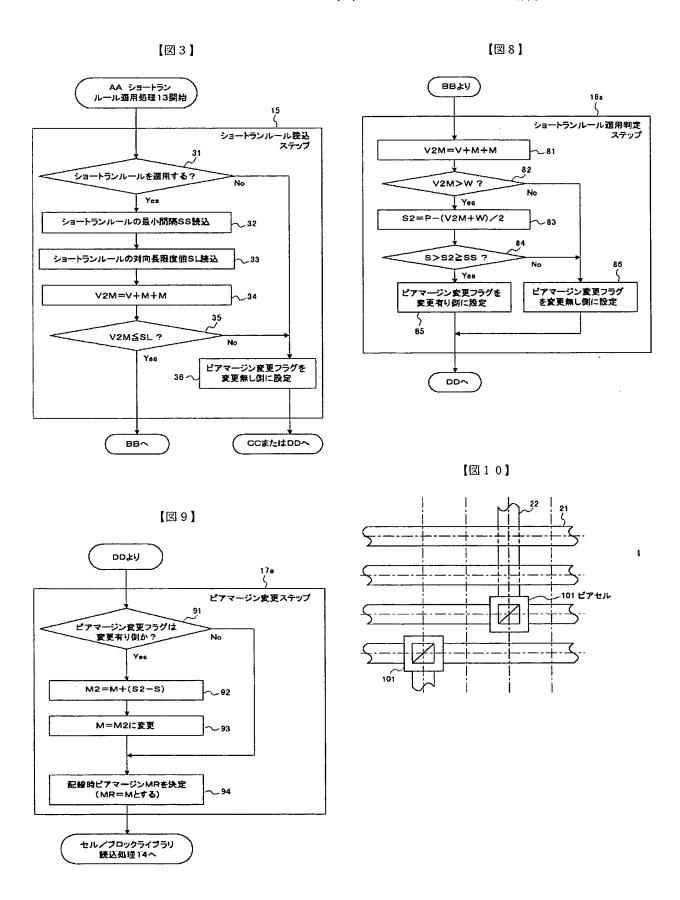
W 配線幅

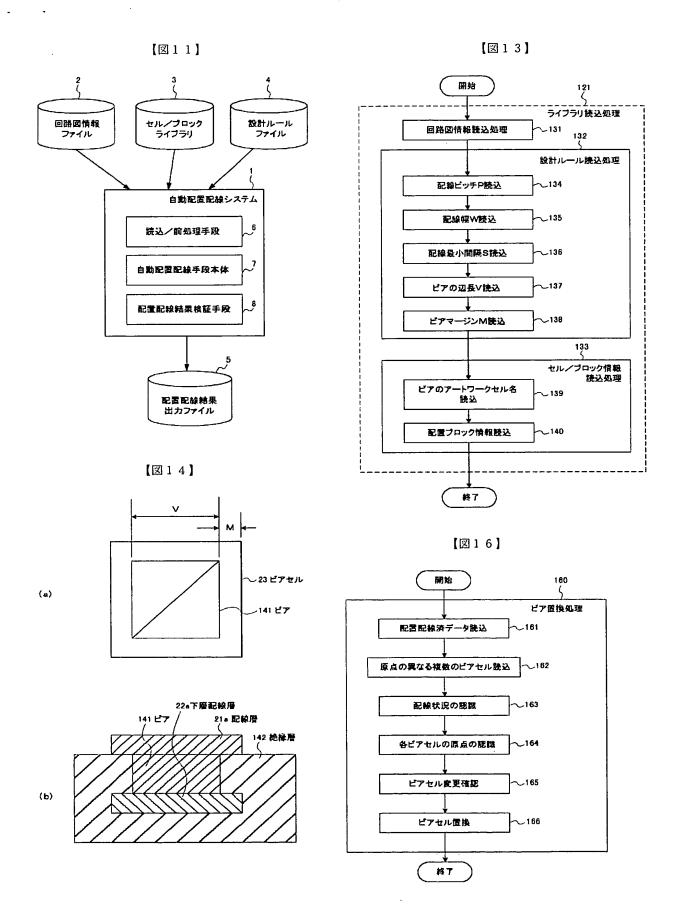
[図6]

【図7】

-12-

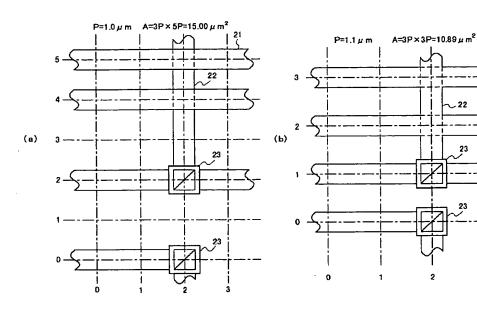




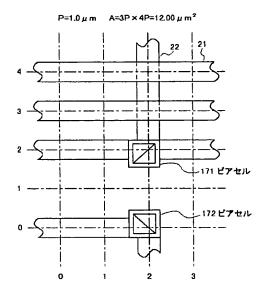


~22

【図15】



【図17】



フロントページの続き

Fターム(参考) 5B046 AA08 BA06 KA06 5F064 EE02 EE08 EE09 EE14 EE19 EE27 EE58 EE60 HH07 HH12 HH15